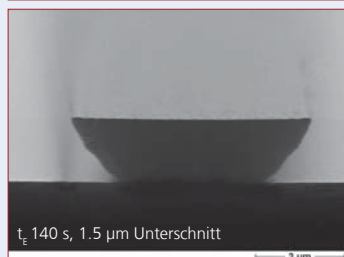
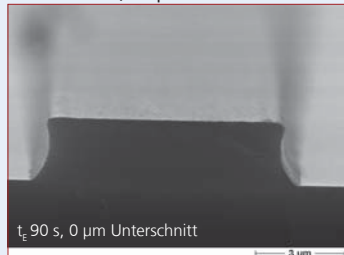


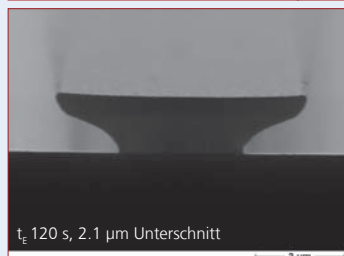
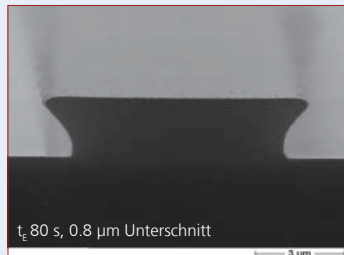
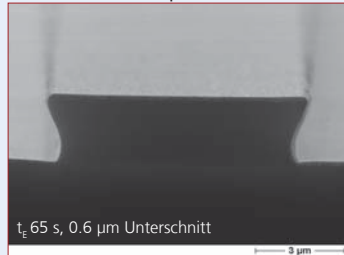
ma-N 400 und ma-N 1400 — Negativ Photoresistserien

Strukturübertragung und Einschicht Lift-Off-Prozess

ma-N 400, 2 µm Schichtdicke



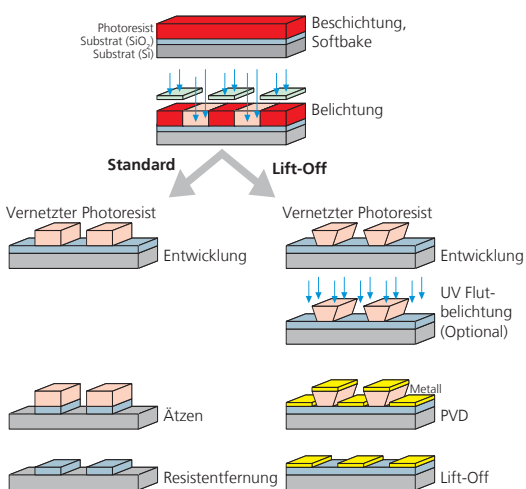
ma-N 1400, 2 µm Schichtdicke



Wichtigste Merkmale

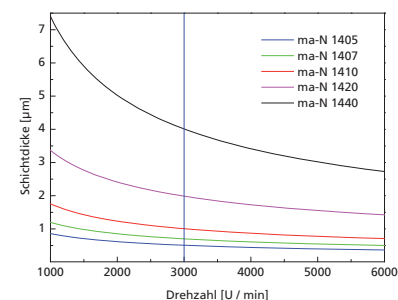
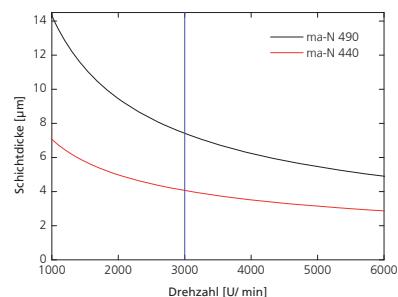
- Hohe Nass- und Trockenätzbeständigkeit
- Gute thermische Stabilität der Resiststrukturen
- Einstellbares Strukturprofil von senkrecht bis stark unterschnitten
- Wässrig-alkalische Entwicklung
- Leicht zu entfernen
- Ungefährliche Lösungsmittel „safe solvents“
- in unterschiedlichen Viskositäten erhältlich

Standard- und Lift-off-Prozess



Anwendungen

- Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik
- Maske für Lift-off Prozesse
- Ätzmaske für Halbleiter und Metalle
- Gut geeignet für Implantationen



Technische Daten

Resist	ma-N 400	µm	ma-N 1400	µm
Schichtdicke	ma-N 440	4,1	ma-N 1405	0,5
	ma-N 490	7,5	ma-N 1407	0,7
			ma-N 1410	1,0
			ma-N 1420	2,0
			ma-N 1440	4,0
Schleuderbeschichtung/ Zeit	3000 min ⁻¹ / 30 s			
Spektrale Empfindlichkeit	300 - 380 nm		300 - 410 nm	
Thermische Stabilität	bis zu 110 °C, für Metallbedampfung		bis zu 160 °C, für Metallbedampfung und Sputtern	

